



Halbleiterpraktikum WS 2011 / 2012

Teilnahmevoraussetzung

- Bestandene Prüfung der Vorlesung „Technologie Hochintegrierter Schaltungen“

Oder

- Bestehen der „Eingangsprüfung zum Praktikum“ am **19.10.2010, 14:00 Uhr, S2/17 Raum 27**

- Inhalt: Technologie Hochintegrierter Schaltungen

Literaturempfehlungen:

- 1) R. C. Jaeger: Introduction to Microelectronic Fabrication, Prentice Hall
- 2) Widmann, Mader, Friedrich: Technologie hochintegrierter Schaltungen, Springer Verlag
- 3) S.M. Sze: VLSI Technology, McGraw-Hill
- 4) I. Ruge: Halbleitertechnologie, Springer Verlag
- 5) A.S. Grove: Physics and Technology of Semiconductor Devices, John Wiley & Sons
- 6) W. Langheinrich: Technologie der integrierten Schaltungen, Skriptum

Institut für Halbleitertechnik
und Nanoelektronik

Institute for Semiconductor
Technology and
Nanoelectronics



INSTITUT für IHTN
HALBLEITERTECHNIK
UND NANOELEKTRONIK

M.Sc. Pia Juliane Wessely

Schlossgartenstraße 8
64289 Darmstadt

Tel. +49 6151 16 - 3931
Fax +49 6151 16 - 5233
pj.wessely@iht.tu-darmstadt.de

Datum
30.08.2011

Ihre Nachricht

Unser Zeichen



Bewertung der erbrachten Leistungen

Die Gesamtbenotung des Halbleiterpraktikums setzt sich aus dem Praktischen Teil, der schriftlichen Ausarbeitung und dem abschließenden Kolloquium zusammen.

- 60% Praktischer Teil und schriftliche Ausarbeitung
- 40% Abschließendes Kolloquium

Schriftliche Ausarbeitung

Die schriftliche Ausarbeitung **muss spätestens 3 Wochen** nach dem Versuch abgegeben werden.

Eine **verspätete Abgabe** wird mit 5,0 bewertet.

Abschließendes Kolloquium

Das „Abschließende Kolloquium“ wird wenige Wochen nach Abschluss des Praktikums stattfinden.

Sie werden hierbei 30 Minuten mündlich geprüft.

Halbleiterpraktikum WS 2011 / 2012



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Versuch	Bezeichnung	Betreuer
V1	Eigenschaften von Silizium	Keyn
V2	Thermische Oxidation	F. Wessely
V3	Fotolithographie	Heß
V4/V5a	Diffusion, Durchführung	Tzschöckel
V5b	Diffusionsauswertung	Tzschöckel
V6	Metallisierung	Heller
V7	Messung von integrierten Widerständen	P. J. Wessely
V9	Prozesssimulation	Schuster
V10	MOS-Kondensator und MOS-Transistor	Birinci

**Versuchsbeginn jeweils 14.00 Uhr !
(nach Einzelabsprache auch andere Termine möglich)**

**Die Teilnahme an der Sicherheitsbelehrung am 19.10.2011 ist
Voraussetzung zur Teilnahme an den Praktikumsversuchen.**

Halbleiterpraktikum WS 2011 / 2012



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Gruppeneinteilung

Gruppe	Name	Vorname
I		
I		
1		

Leider gibt es in diesem Jahr nur 3 Praktikumsplätze, da uns zur Durchführung des Praktikums keine QSL-Mittel zugeteilt wurden. Studenten mit Prüfung in THIS werden bevorzugt, prinzipiell herrscht das First-Come-First-Serve Prinzip.

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt im Sekretariat S2-17/29 bei Frau Rose.

Terminplan

Mi 19.10.2011	Eingangsprüfung, Sicherheitsbelehrung (obligatorisch), Materialvergabe
Mi 26.10.2011	1
Mi 02.11.2011	2
Mi 09.11.2011	3
Mi 16.11.2011	4/5a
Mi 23.11.2011	5b
Mi 30.11.2011	6
Mi 07.12.2011	7
Mi 14.12.2011	9
Mi 21.12.2011	10
Nach Absprache 2012	Kolloquium (obligatorisch)

gezeichnet